

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN

CHỨC DANH: PHÓ GIÁO SƯ

Mã hồ sơ:.....

(Nội dung đúng ở ô nào thì đánh dấu vào ô đó: ; Nội dung không đúng thì để trống:)

Đối tượng đăng ký: Giảng viên ; Giảng viên thỉnh giảng

Ngành: Vật lý; Chuyên ngành: Khoa học Vật liệu

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên người đăng ký: Đào Vĩnh Ái

2. Ngày tháng năm sinh: 20/10/1977; Nam ; Nữ ; Quốc tịch: Việt Nam;

Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Công giáo

3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam:

4. Quê quán: xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố: Nhơn Tân, An Nhơn, Bình Định.

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (số nhà, phố, phường, quận, thành phố hoặc xã, huyện, tỉnh): 57/4N1, Phạm Văn Chiêu, Phường 14, Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

6. Địa chỉ liên hệ (ghi rõ, đầy đủ để liên hệ được qua Bru điện): 1D đường TL29, Phường Thanh Lộc, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại nhà riêng: 0971861250; Điện thoại di động: 0971861250;

E-mail: daovinhai@duytan.edu.vn

7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan):

Từ tháng, năm 02,2000 đến tháng, năm 08,2002: Giám sát sản xuất tại Công ty Dệt may Hualon Việt Nam

Từ tháng, năm 09,2002 đến tháng, năm 04,2003: Kỹ sư cải tiến công đoạn tại Công ty Nissei Electric Vietnam

Từ tháng, năm 10,2003 đến tháng, năm 02,2007: Trợ giảng tại Bộ môn Khoa học Vật liệu, Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên, Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh

Từ tháng, năm 09,2011 đến tháng, năm 06,2016: Giáo sư nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm Linh kiện Thông tin và Truyền thông, Khoa Kỹ thuật Điện-Điện tử, Trường Đại học Kỹ thuật Thông tin và Truyền thông, Đại học Sungkyunkwan, Hàn Quốc

Từ tháng, năm 07,2016 đến tháng, năm 06,2018: Giảng viên tại Bộ môn Công nghệ Vật liệu, Khoa Khoa học Ứng Dụng, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh

Chức vụ hiện nay: Trưởng Phòng thí nghiệm; Chức vụ cao nhất đã qua: Trưởng Phòng thí nghiệm

Cơ quan công tác hiện nay: Viện Nghiên cứu Khoa học Cơ bản và Ứng Dụng, Trường Đại học Duy Tân

Địa chỉ cơ quan: 06 Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại cơ quan:

Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (nếu có): Bộ môn Công nghệ Vật liệu và Bộ môn Vật lý, Khoa Khoa học Ứng dụng, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh

8. Đã nghỉ hưu từ tháng ... năm ...

Nơi làm việc sau khi nghỉ hưu (nếu có):

Tên cơ sở giáo dục đại học nơi hợp đồng thỉnh giảng 3 năm cuối (tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ): Bộ môn Công nghệ Vật liệu và Bộ môn Vật lý, Khoa Khoa học Ứng dụng, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh

9. Trình độ đào tạo:

- Được cấp bằng ĐH [3] ngày 15 tháng 09 năm 1999, số văn bằng: B151906, ngành: Vật lý, chuyên ngành: Vật lý ứng dụng; Nơi cấp bằng ĐH [3] (trường, nước): Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

- Được cấp bằng ThS [4] ngày 10 tháng 05 năm 2005, số văn bằng: 00349/71KH2, ngành: Vật lý, chuyên ngành: Vật lý Điện tử; Nơi cấp bằng ThS [4] (trường, nước): Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Được cấp bằng TS [5] ngày 25 tháng 08 năm 2011, số văn bằng: SKKU 2010(D) 343, ngành: Kỹ thuật Điện tử và Máy tính, chuyên ngành: Vật liệu và Linh kiện điện tử; Nơi cấp bằng TS [5] (trường, nước): Đại học Sungkyunkwan, Hàn Quốc

10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS ngày ... tháng ... năm ..., ngành: ...

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HĐGS cơ sở: Trường Đại học Duy Tân

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HĐGS ngành, liên ngành: Vật lý

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu:

- Cơ chế truyền dẫn hạt tải trong các loại pin mặt trời dị thể trên nền Silic;
- Phát triển cấu trúc mới cho lớp emitter trong pin mặt trời dị thể a-Si:H/c-Si;
- Ứng dụng phép xấp xỉ thống kê trong việc tối ưu hóa màng bán dẫn điện trong suốt trong pin mặt trời;
- Phát triển pin mặt trời có cấu trúc tandem;
- Pin mặt trời màng mỏng truyền suốt.

14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học:

- Đã hướng dẫn (số lượng) 0 NCS bảo vệ thành công luận án TS;

- Đã hướng dẫn (số lượng) 2 HVCH/CK2/BSNT bảo vệ thành công luận văn ThS/CK2/BSNT (ứng viên chức danh GS không cần kê khai nội dung này);

- Đã hoàn thành đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên: 1 cấp Nhà nước;

- Đã công bố (số lượng) 61 bài báo khoa học, trong đó 55 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín;

- Đã được cấp (số lượng) 0 bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích;
- Số lượng sách đã xuất bản 0, trong đó 0 thuộc nhà xuất bản có uy tín;
- Số lượng tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục, thể thao đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế: 0

15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu):

TT	Tên khen thưởng	Cấp khen thưởng	Năm khen thưởng
1	Giải ba: Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 1999	Bộ Giáo dục và đào tạo	1999
2	Giải khuyến khích: Giải thưởng khoa học sinh viên EUREKA lần thứ nhất năm học 1998-1999	ĐH Quốc Gia TP.HCM	1999

16. Kỷ luật (hình thức từ khiển trách trở lên, cấp ra quyết định, số quyết định và thời hạn hiệu lực của quyết định):

TT	Tên kỷ luật	Cấp ra quyết định	Số quyết định	Thời hạn hiệu lực
Không có				

B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ

1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo:

- Có đủ tiêu chuẩn của nhà giáo, theo Luật Giáo dục Đại học, luôn luôn rèn luyện phẩm chất và đạo đức của một nhà giáo;
- Không ngừng học tập nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Sống trung thực, có trách nhiệm, khiêm tốn, hòa đồng và giúp đỡ đồng nghiệp trong các hoạt động giáo dục, nghiên cứu khoa học và công nghệ. Sống công hiến và truyền nhiệt huyết đến các thế hệ học trò.
- Nhiệt huyết và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

2. Thời gian, kết quả tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên:

- Tổng số năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo: 06 năm 0 tháng

- Khai cụ thể ít nhất 06 năm học, trong đó có 03 năm học cuối liên tục tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ (ứng viên GS chỉ khai 3 năm cuối liên tục sau khi được công nhận PGS):

TT	Năm học	Số lượng NCS đã hướng dẫn		Số lượng ThS/CK2/BSNT đã hướng dẫn	Số đồ án, khóa luận tốt nghiệp ĐH đã HD	Số giờ chuẩn gd trực tiếp trên lớp		Tổng số giờ chuẩn gd trực tiếp trên lớp/số giờ chuẩn gd quy đổi/số giờ chuẩn định mức (*)
		Chính	Phụ			ĐH	SDH	
1	2016-2017					63		63.00/63.00/270
2	2017-2018					326.59		326.59/326.59/270
3	2018-2019					150.2		150.20/150.20/135
03 năm học cuối								
4	2019-2020				3	256.35		256.35/286.35/135
5	2020-2021					248.51		248.51/248.51/135
6	2021-2022					240.68		240.68/240.68/135

(*) - Trước ngày 25/3/2015, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 36/2010/TT-BGDĐT ngày 15/12/2010 và Thông tư số 18/2012/TT-BGDĐT ngày 31/5/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

- Từ 25/3/2015 đến nay, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

- Từ ngày 11/9/2020 đến nay, theo Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học ban hành kèm theo Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; định mức giờ chuẩn giảng dạy theo quy định của thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học, trong đó định mức của giảng viên thỉnh giảng được tính trên cơ sở định mức của giảng viên cơ hữu.

3. Ngoại ngữ

3.1. Ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: Tiếng Anh

a) Được đào tạo ở nước ngoài :

- Học ĐH ; Tại nước: ; Từ năm đến năm

- Bảo vệ luận văn ThS hoặc luận án TS hoặc TSKH ; Tại nước: Hàn Quốc năm 2011

b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước :

- Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ: số bằng: ; năm cấp:

c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài :

- Giảng dạy bằng ngoại ngữ: Tiếng Anh

- Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước): Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, Việt Nam

d) Đối tượng khác ; Diễn giải:

3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ):

4. Hướng dẫn NCS, HVCH/CK2/BSNT đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng

TT	Họ tên NCS hoặc HVCH/ CK2/ BSNT	Đối tượng		Trách nhiệm hướng dẫn		Thời gian hướng dẫn từ ... đến ...	Cơ sở đào tạo	Ngày, tháng, năm được cấp bằng/có quyết định cấp bằng
		NCS	HVCH/ CK2/ BSNT	Chính	Phụ			
1	Trương Doãn Việt		X	X		12/2017 đến 05/2020	ĐH KHTN, ĐH QG TPHCM	19/07/2021
2	Ngô Thị Thanh Giang		X	X		12/2017 đến 05/2020	ĐH KHTN TPHCM, ĐH QG TPHCM	26/04/2022

Ghi chú: Ứng viên chức danh GS chỉ kê khai thông tin về hướng dẫn NCS.

5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên

TT	Tên sách	Loại sách (CK, GT, TK, HD)	Nhà xuất bản và năm xuất bản	Số tác giả	Chủ biên	Phần biên soạn (từ trang ... đến trang)	Xác nhận của cơ sở GDDH (Số văn bản xác nhận sử dụng sách)
----	----------	--	---------------------------------------	------------------	-------------	--	--

Không có

Trong đó, số lượng (ghi rõ các số TT) sách chuyên khảo do nhà xuất bản có uy tín xuất bản và chương sách do nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản, mà ứng viên là chủ biên sau PGS/TS: 0 ()

Lưu ý:

- Chi kê khai các sách được phép xuất bản (Giấy phép XB/Quyết định xuất bản/số xuất bản), nộp lưu chiểu, ISBN (nếu có).

- Các chữ viết tắt: CK: sách chuyên khảo; GT: sách giáo trình; TK: sách tham khảo; HD: sách hướng dẫn; phần ứng viên biên soạn cần ghi rõ từ trang.... đến trang..... (ví dụ: 17-56; 145-329).

6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu

TT	Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ (CT, ĐT...)	CN/PCN/TK	Mã số và cấp quản lý	Thời gian thực hiện	Thời gian nghiệm thu (ngày, tháng, năm) / Xếp loại KQ
Sau khi bảo vệ học vị tiến sĩ					
1	Pin mặt trời dị thể Silicon với kim loại chuyển tiếp đóng vai trò trích xuất hạt tải lỗ trống: Cơ chế truyền dẫn hạt tải	CN	103.02-2017.43, cấp Nhà nước	01/03/2018 đến 01/03/2021	25/01/2021, xếp loại: đạt

- Các chữ viết tắt: CT: Chương trình; ĐT: Đề tài; CN: Chủ nhiệm; PCN: Phó chủ nhiệm; TK: Thư ký.

7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, báo cáo khoa học, sáng chế/giải pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế):

7.1.a. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố:

TT	Tên bài báo/báo cáo KH	Số tác giả	Là tác giả chính	Tên tạp chí hoặc kỷ yếu khoa học/ISSN hoặc ISBN	Loại Tạp chí quốc tế uy tín: ISI, Scopus (IF, Qi)	Số lần trích dẫn (không tính tự trích dẫn)	Tập, số, trang	Tháng, năm công bố
Trước khi bảo vệ học vị tiến sĩ								

1	Hệ magnetron phẳng cân bằng ở áp suất thấp và ứng dụng nó để kim loại hóa Compact-disks (CDs)	3	Có	Science and Technology Development Journal (STDJ), Vietnam National University – Ho Chi Minh City (ISSN: 1859-0128)	- Hệ thống CSDL quốc tế khác		2, 8-1999, 37-44	06/1999
2	Hoàn thiện quy trình tạo màng ZnO:Al với kích thước lớn	5	Không	Science and Technology Development Journal (STDJ), Vietnam National University – Ho Chi Minh City (ISSN: 1859-0128)	- Hệ thống CSDL quốc tế khác		8, 2-2005, 29-34	12/2004
3	Chế tạo máy chưng cất nước bằng năng lượng mặt trời với màng gương nóng truyền qua ZnO:Al	4	Không	Science and Technology Development Journal (STDJ), Vietnam National University – Ho Chi Minh City (ISSN: 1859-0128)	- Hệ thống CSDL quốc tế khác		8, 4/2005, 28-33	12/2004
4	Effect of defect densities and band offsets on carrier transport mechanism in mixed phase silicon/crystalline silicon heterojunction	6	Có	Journal of the Korean Physical Society (ISSN: 1976-8524)	Tạp chí quốc tế uy tín - SCI <i>IF: 0.649, Q4</i>		53, 2, 704-708	08/2008

5	Electrical and optical studies of transparent conducting ZnO: Al thin films by magnetron dc sputtering	9	Có	Journal of electroceramics (ISSN: 1385-3449)	Tạp chí quốc tế uy tín - SCI <i>IF</i> : <i>IF</i> = 1.785, Q3	12	23, 2, 356-360	03/2008
6	Hydrogenated Amorphous Silicon Layer Formation by Inductively Coupled Plasma Chemical Vapor Deposition and Its Application for Surface Passivation of p-Type Crystalline Silicon	6	Có	Japanese Journal of Applied Physics (ISSN: 0021-4922)	Tạp chí quốc tế uy tín - SCI <i>IF</i> : <i>IF</i> = 1.480, Q2	9	48, 6R, 066509	06/2009

7	Effect of N ₂ O/SiH ₄ flow ratios on properties of amorphous silicon oxide thin films deposited by inductively-coupled plasma chemical vapor deposition with application to silicon surface passivation	7	Có	Vacuum (ISSN: 0042-207X)	Tạp chí quốc tế uy tín - SCI <i>IF</i> : <i>IF</i> = 3.627, Q1	12	84, 3, 410-414	11/2009
8	Fabrication of polycrystalline silicon thin films on glass substrates using fiber laser crystallization	10	Có	Thin Solid Films (ISSN: 0040-6090)	Tạp chí quốc tế uy tín - SCI <i>IF</i> : <i>IF</i> = 2.183, Q2	6	517, 14, 3971- 3974	05/2009
9	Selective emitter using porous silicon for crystalline silicon solar cells	12	Không	Solar Energy Materials & Solar Cells (ISSN: 0927-0248)	Tạp chí quốc tế uy tín - SCI <i>IF</i> : <i>IF</i> = 7.267, Q1	17	93, 6-7, 846- 850	06/2009

10	rf-Magnetron sputtered ITO thin films for improved heterojunction solar cell applications	9	Có	Current Applied Physics (ISSN: 1567-1739)	Tạp chí quốc tế uy tín - SCI <i>IF</i> : <i>IF</i> = 2.480, Q2	60	10, 3, 506-509	05/2010
11	Optimized surface passivation of n and p type silicon wafers using hydrogenated SiNx layers	6	Có	Journal of Non-Crystalline Solids (ISSN: 0022-3093)	Tạp chí quốc tế uy tín - SCI <i>IF</i> : <i>IF</i> = 3.531, Q1	10	356, 50- 51, 2880- 2883	11/2010
12	Simulation and study of the influence of the buffer intrinsic layer, back-surface field, densities of interface defects, resistivity of p-type silicon substrate and transparent conductive oxide on heterojunction with intrinsic thin-layer (HIT) solar cell	8	Có	Solar Energy (0038-092X)	Tạp chí quốc tế uy tín - SCI <i>IF</i> : <i>IF</i> = 5.742, Q1	97	84, 5, 777- 783	05/2010

13	Interface Characterization and Electrical Transport Mechanisms in a-Si:H/c-Si Heterojunction Solar Cells	6	Có	Journal of The Electrochemical Society (ISSN:0013-4651)	Tạp chí quốc tế uy tín - SCI <i>IF</i> : <i>IF 4.136, Q1</i>	33	158, 3, 312	01/2011
14	The mechanisms of negative oxygen ion formation from Al-doped ZnO target and the improvements in electrical and optical properties of thin films using off-axis dc magnetron sputtering at low temperature	8	Có	Semiconductor Science and Technology (ISSN: 0268-1242)	Tạp chí quốc tế uy tín - SCI <i>IF</i> : <i>IF = 2.352, Q2</i>	18	26, 10, 105022	08/2011
Sau khi bảo vệ học vị tiến sĩ								
15	Effect of Valence Band Offset and Surface Passivation Quality in the Silicon Heterojunction Solar Cells	8	Có	Journal of The Electrochemical Society (ISSN:0013-4651)	Tạp chí quốc tế uy tín - SCI <i>IF</i> : <i>IF 4.136, Q1</i>	13	158, 11, 1129	10/2011

16	Operation mechanism of Schottky barrier nonvolatile memory with high conductivity InGaZnO active layer	9	Không	Applied Physics Letters (ISSN: 0003-6951)	Tạp chí quốc tế uy tín - SCI IF: IF = 3.791, Q1	20	100, 14, 143502	04/2012
17	The Compromise Condition for High Performance of the Single Silicon Heterojunction Solar Cells	8	Không	International Journal of Photoenergy (ISSN: 1110-662X)	Tạp chí quốc tế uy tín - SCIE IF: IF = 2.113, Q3		2012 283872	01/2012
18	Ultrathin oxide passivation layer by rapid thermal oxidation for the silicon heterojunction solar cell applications	5	Không	International Journal of Photoenergy (ISSN: 1110-662X)	Tạp chí quốc tế uy tín - SCIE IF: IF = 2.113, Q3	25	2012 753456	01/2012

19	Low defect interface study of intrinsic layer for c-Si surface passivation in a-Si:H/c-Si heterojunction solar cells	9	Không	Thin Solid Films (ISSN: 0040-6090)	Tạp chí quốc tế uy tín - SCI <i>IF</i> : <i>IF</i> = 2.183, Q2	28	521 45- 49	10/2012
20	Trapping time characteristics of carriers in a-InGaZnO thin-film transistors fabricated at low temperatures for next-generation displays	5	Có	Journal of electronic materials (ISSN: 0361-5235)	Tạp chí quốc tế uy tín - SCI <i>IF</i> : <i>IF</i> = 1.938, Q2	8	42, 4, 711- 715	12/2012
21	Effects of LiF/Al back electrode on the amorphous/crystalline silicon heterojunction solar cells	12	Không	Materials Science and Engineering: B (ISSN: 0921-5107)	Tạp chí quốc tế uy tín - SCI <i>IF</i> : <i>IF</i> : 4.051, Q2	24	178, 9, 660- 664	11/2012

22	A study of tunnel recombination junction on a-Si: H/HIT tandem structure solar cell	6	Không	2013 IEEE 39th Photovoltaic Specialists Conference (PVSC), Tampa, FL, USA, 16-21 June 2013 (ISSN: 0160-8371)	- Scopus	3	1361-1363	06/2013
23	Bias-stress-induced threshold voltage shift dependence of negative charge trapping in the amorphous indium tin zinc oxide thin-film transistors	8	Không	Semiconductor Science and Technology (ISSN: 0268-1242)	Tạp chí quốc tế uy tín - SCI IF: IF = 2.352, Q2	18	28, 10, 105014	08/2013
24	Processed optimization for excellent interface passivation quality of amorphous/crystalline silicon solar cells	7	Không	Solar Energy Materials & Solar Cells (ISSN: 0927-0248)	Tạp chí quốc tế uy tín - SCI IF: IF = 7.267, Q1	22	117-174-177	10/2013

25	Interfacial barrier height modification of indium tin oxide/a-Si: H (p) via control of density of interstitial oxygen for silicon heterojunction solar cell application	13	Không	Thin Solid Films (ISSN: 0040-6090)	Tạp chí quốc tế uy tín - SCI IF: IF = 2.183, Q2	14	546 342-346	11/2013
26	A buffer-layer/a-SiOx: H (p) window-layer optimization for thin film amorphous silicon based solar cells	8	Không	Thin Solid Films (ISSN: 0040-6090)	Tạp chí quốc tế uy tín - SCI IF: IF = 2.183, Q2	28	546 331-336	11/2013
27	A statistical approach for the optimization of indium tin oxide films used as a front contact in amorphous/crystalline silicon heterojunction solar cells	9	Có	Energy conversion and management (ISSN: 0196-8904)	Tạp chí quốc tế uy tín - SCIE IF: IF = 9.709, Q1	12	87 191-198	11/2014

28	Improvement of haze ratio of DC (direct current)-sputtered ZnO: Al thin films through HF (hydrofluoric acid) vapor texturing	10	Không	Energy (ISSN: 0360-5442)	Tạp chí quốc tế uy tín - SCI IF: IF = 7.147, Q1	14	66 20-24	03/2014
29	Improved hydrogen capping effect in n-type crystalline silicon solar cells by SiN (Si-Rich)/SiN (N-rich) stacked passivation	10	Không	Journal of electronic materials (ISSN: 0361-5235)	Tạp chí quốc tế uy tín - SCI IF: IF = 1.938, Q2	2	43, 9, 3191-3195	09/2014
30	The effects of orientation changes in indium tin oxide films on performance of crystalline silicon solar cell with shallow-emitter	10	Có	Materials Letters (ISSN: 0167577X)	Tạp chí quốc tế uy tín - SCI IF: IF = 3.423, Q 2	6	132 322-362	10/2014

31	Effect of high conductivity amorphous InGaZnO active layer on the field effect mobility improvement of thin film transistors	4	Không	Journal of Applied Physics (ISSN: 0021-8979)	Tạp chí quốc tế uy tín - SCI IF: IF = 2.546, Q2	15	116, 21, 214504	12/2014
32	Performance of hetero junction with intrinsic thin-layer solar cell depending upon contact resistivity of front electrode	8	Không	Journal of Photonics for Energy (ISSN: 1947-7988)	Tạp chí quốc tế uy tín - SCIE IF: IF = 1.836, Q3	9	4, 1, 043094	05/2014
33	Role of double ITO/In2O3 layer for high efficiency amorphous/crystalline silicon heterojunction solar cells	11	Không	Materials Research Bulletin (ISSN: 0025-5408)	Tạp chí quốc tế uy tín - SCI IF: IF = 4.641, Q1	21	58 83-87	10/2014

34	Effective optimization of indium tin oxide films by a statistical approach for shallow emitter based crystalline silicon solar cell applications	10	Không	Solar Energy Materials & Solar Cells (ISSN: 0927-0248)	Tạp chí quốc tế uy tín - SCI IF: IF = 7.267, Q1	16	125 176-183	06/2014
35	Free-carrier absorption and Burstein–Moss shift effect on quantum efficiency in heterojunction silicon solar cells	10	Có	Vacuum (ISSN: 0042-207X)	Tạp chí quốc tế uy tín - SCI IF: IF = 3.627, Q1	12	108 39- 44	10/2014
36	In and Ga codoped ZnO film as a front electrode for thin film silicon solar cells	8	Không	Advances in Condensed Matter Physics (ISSN: 1687-8108)	Tạp chí quốc tế uy tín - SCIE IF: IF = 1.845, Q4	25	2014 971528	01/2014

37	Study of stacked-emitter layer for high efficiency amorphous/crystalline silicon heterojunction solar cells	9	Có	Journal of Applied Physics (ISSN: 0021-8979)	Tạp chí quốc tế uy tín - SCI IF: IF = 2.546, Q2	15	116, 24, 244506	12/2014
38	High efficiency silicon solar cells: A review	5	Có	Israel Journal of Chemistry (ISSN: 0021-2148)	Tạp chí quốc tế uy tín - SCI IF: IF = 3.333, Q1	59	55, 10, 1050-1063	10/2015
39	n-type hydrogenated microcrystalline silicon/indium tin oxide back-reflector interfacial characterization for micromorph tandem solar cell applications	6	Có	Journal of Renewable and Sustainable Energy (ISSN: 1941-7012)	Tạp chí quốc tế uy tín - SCIE IF: IF = 2.219, Q3		7, 3, 033112	05/2015

40	Source/drain metallization effects on the specific contact resistance of indium tin zinc oxide thin film transistors	7	Có	Materials Science in Semiconductor Processing (ISSN: 1369-8001)	Tạp chí quốc tế uy tín - SCI <i>IF</i> : <i>IF</i> = 3.927, Q2	14	39 649-653	11/2015
41	Role of Schottky barrier height at source/drain contact for electrical improvement in high carrier concentration amorphous InGaZnO thin film transistors	5	Có	Materials Science in Semiconductor Processing (ISSN: 1369-8001)	Tạp chí quốc tế uy tín - SCI <i>IF</i> : <i>IF</i> = 3.927, Q2	13	38 50-56	10/2015
42	Effect of thermal annealing on the optical and electrical properties of boron doped a-SiO _x :H for thin-film silicon solar cell applications	9	Không	Thin Solid Films (ISSN: 0040-6090)	Tạp chí quốc tế uy tín - SCI <i>IF</i> : <i>IF</i> = 2.183, Q2	13	587 132-136	07/2015

43	Improvement in front-contact resistance and interface passivation of heterojunction amorphous/crystalline silicon solar cell by hydrogen-diluted stacked emitter	9	Có	IEEE Journal of Photovoltaics (ISSN: 2156-3381)	Tập chí quốc tế uy tín - SCIE <i>IF</i> : <i>IF</i> = 3.889, Q1	16	9, 4, 837-845	05/2016
44	Role of SiOxNy surface passivation layer on stability improvement and kink effect reduction of ELA poly silicon thin film transistors	4	Có	Microelectronic Engineering (ISSN: 0167-9317)	Tập chí quốc tế uy tín - SCI <i>IF</i> : <i>IF</i> = 2.523, Q2	3	164 14-19	10/2016

45	Current transport studies of amorphous n/p junctions and its application in a-Si:H/HIT type tandem cells	5	Có	Progress in Photovoltaics: Research and Applications (ISSN: 1062-7995)	Tạp chí quốc tế uy tín - SCI <i>IF</i> : <i>IF</i> = 7.953, Q1	20	24, 1, 52-58	01/2016
46	Al ₂ O ₃ /SiON stack layers for effective surface passivation and anti-reflection of high efficiency n-type c-Si solar cells	10	Có	Semiconductor Science and Technology (ISSN: 0268-1242)	Tạp chí quốc tế uy tín - SCI <i>IF</i> : <i>IF</i> = 2.352, Q2	10	32, 2, 025005	01/2017
47	High efficiency inorganic/inorganic amorphous silicon/heterojunction silicon tandem solar cells	8	Có	Scientific reports (ISSN: 2045-2322)	Tạp chí quốc tế uy tín - SCIE <i>IF</i> : <i>IF</i> = 4.380, Q1	12	8, 1, 1-11	10/2018
48	The effect of band gap of a-SiGe:H intrinsic layer in heterojunction Silicon solar cells	5	Có	Tạp Chí Khoa Học & Công Nghệ Đại học Duy Tân (ISSN: 1859 - 4905)			4, 35, 58-63	08/2019

49	The effects of refractive index and defects in silicon oxide films on the passivation qualities in c-Si solar cells	9	Có	Tạp Chí Khoa Học & Công Nghệ Đại học Duy Tân (ISSN: 1859 - 4905)			4, 35, 80-85	08/2019
50	In Situ Process to Form Passivated Tunneling Oxides for Front-Surface Field in Rear-Emitter Silicon Heterojunction Solar Cells	9	Có	ACS Sustainable Chemistry & Engineering (ISSN: 2168-0485)	Tạp chí quốc tế uy tín - SCIE IF: IF = 8.198, Q1	1	7, 24, 19332-19337	11/2019
51	Damage to passivation contact in silicon heterojunction solar cells by ITO sputtering under various plasma excitation modes	9	Có	Solar Energy Materials & Solar Cells (ISSN: 0927-0248)	Tạp chí quốc tế uy tín - SCI IF: IF = 7.267, Q1	26	192 36-45	04/2019

52	The recorded open-circuit voltage and fill factor achievement of a-Si:H pi-n/HIT-type tandem solar cells by tuning up the crystalline in tunneling recombination junction layer	10	Có	Semiconductor Science and Technology (ISSN: 0268-1242)	Tạp chí quốc tế uy tín - SCI <i>IF</i> : <i>IF</i> = 2.352, Q2	4	34 065004	03/2019
53	Improvement of the storage ability of Si-rich oxide layer in poly-Si based nonvolatile memory devices by implementation of taguchi method	7	Có	Semiconductor Science and Technology (ISSN: 0268-1242)	Tạp chí quốc tế uy tín - SCI <i>IF</i> : <i>IF</i> = 2.352, Q2		34, 9, 095020	08/2019

54	Effects of oxidation state on photovoltaic properties of reactively magnetron sputtered hole-selective WO _x contacts in silicon heterojunction solar cells	9	Có	Semiconductor Science and Technology (ISSN: 0268-1242)	Tạp chí quốc tế uy tín - SCI <i>IF</i> : <i>IF</i> = 2.352, Q2	3	35, 4, 045020	03/2020
55	Carrier transport mechanisms of reactively direct current magnetron sputtered tungsten oxide/n-type crystalline silicon heterojunction	10	Có	Journal of Power Sources (ISSN: 0378-7753)	Tạp chí quốc tế uy tín - SCI <i>IF</i> : <i>IF</i> = 9.127, Q1	2	472 228460	10/2020
56	Transparent photovoltaic cells and self-powered photodetectors by TiO ₂ /NiO heterojunction	7	Có	Journal of Power Sources (ISSN: 0378-7753)	Tạp chí quốc tế uy tín - SCI <i>IF</i> : <i>IF</i> = 9.127, Q1	36	481 228865	01/2021

57	Transparent Stacked Photoanodes with Efficient Light Management for Solar-Driven Photoelectrochemical Cells	5	Có	ACS Applied Materials & Interfaces (ISSN: 1944-8244)	Tạp chí quốc tế uy tín - SCI <i>IF</i> : <i>IF</i> = 9.229, Q1	7	13, 8, 10181-10190	02/2021
58	Over 30% efficiency bifacial 4-terminal perovskite-heterojunction silicon tandem solar cells with spectral albedo	10	Có	Scientific Reports (ISSN: 20452322)	Tạp chí quốc tế uy tín - SCIE <i>IF</i> : <i>IF</i> = 4.380, Q1	12	11, 1, 1-10	07/2021
59	A study on the influence of the albedo spectrum on the bifacial GaAs/c-Si heterojunction tandem solar cell using computer modelling	10	Có	Solar Energy (ISSN: 0038-092X)	Tạp chí quốc tế uy tín - SCI <i>IF</i> : <i>IF</i> = 5.742, Q1		227 440-496	10/2021

60	Crystalline silicon photovoltaic module degradation: Galvanic corrosion and its solution	7	Không	Engineering Failure Analysis (ISSN: 13506307)	Tạp chí quốc tế uy tín - SCIE IF: IF = 3.114, Q1	138 106329	08/2022
61	Enhancement of photoconversion efficiency of CdSe quantum dots sensitized Al doped ZnO/Si heterojunction device decorated with Ag nanostructures	9	Không	Materials Science in Semiconductor Processing (13698001)	Tạp chí quốc tế uy tín - SCIE IF: IF = 3.927, Q2	149 106878	10/2022

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín mà UV là tác giả chính sau PGS/TS: 25 ([15] [20] [27] [30] [35] [37] [38] [39] [40] [41] [43] [44] [45] [46] [47] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59])

7.1.b. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố (*Dành cho các chuyên ngành thuộc ngành KH An ninh và KH Quân sự được quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg*)

TT	Tên bài báo/báo cáo KH	Số tác giả	Là tác giả chính	Tên tạp chí hoặc kỷ yếu khoa học/ISSN hoặc ISBN	Thuộc danh mục tạp chí uy tín của ngành	Tập, số, trang	Tháng, năm công bố
Không có							

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học uy tín của ngành mà UV là tác giả chính sau PGS/TS:

7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích

TT	Tên bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích	Tên cơ quan cấp	Ngày tháng năm cấp	Tác giả chính/ đồng tác giả	Số tác giả
Không có					

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích được cấp, là tác giả chính sau PGS/TS:

7.3. Tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế (đối với ngành Văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao)

TT	Tên tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu TDTT	Cơ quan/tổ chức công nhận	Văn bản công nhận (số, ngày, tháng, năm)	Giải thưởng cấp Quốc gia/Quốc tế	Số tác giả
Không có					

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu đạt giải thưởng quốc tế, là tác giả chính/hướng dẫn chính sau PGS/TS:

8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương trình/dự án/đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại học đã được đưa vào áp dụng thực tế:

TT	Chương trình đào tạo, chương trình nghiên cứu ứng dụng KHCN	Vai trò UV (Chủ trì/ Tham gia)	Văn bản giao nhiệm vụ (số, ngày, tháng, năm)	Cơ quan thẩm định, đưa vào sử dụng	Văn bản đưa vào áp dụng thực tế	Ghi Chú
Không có						

9. Các tiêu chuẩn còn thiếu so với quy định cần được thay thế bằng bài báo khoa học quốc tế uy tín*:

a) Thời gian được bổ nhiệm PGS

Được bổ nhiệm PGS chưa đủ 3 năm: thiếu (số lượng năm, tháng):

b) Hoạt động đào tạo

- Thâm niên đào tạo chưa đủ 6 năm (UV PGS), còn thiếu (số lượng năm, tháng):

- Giờ giảng dạy

+ Giờ chuẩn giảng dạy trực tiếp trên lớp không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu):

+ Giờ chuẩn giảng dạy quy đổi không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu):

- Hướng dẫn chính NCS/HVCH,CK2/BSNT:

+ Đã hướng dẫn chính 01 NCS đã có Quyết định cấp bằng TS (UV chức danh GS)

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 NCS được cấp bằng TS bị thiếu:

+ Đã hướng dẫn chính 01 HVCH/CK2/BSNT đã có Quyết định cấp bằng ThS/CK2/BSNT (UV chức danh PGS)

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 HVCH/CK2/BSNT được cấp bằng ThS/CK2/BSNT bị thiếu:

c) Nghiên cứu khoa học

- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ (UV chức danh GS)

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ bị thiếu:

- Đã chủ trì không đủ 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (UV chức danh PGS)

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở bị thiếu:

- Không đủ số CTKH là tác giả chính sau khi được bổ nhiệm PGS hoặc được cấp bằng TS:

+ Đối với ứng viên chức danh GS, đã công bố được: 03 CTKH ; 04 CTKH

Đề xuất sách CKUT/chương sách của NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay thế cho việc UV không đủ 05 CTKH là tác giả chính theo quy định:

+ Đối với ứng viên chức danh PGS, đã công bố được: 02 CTKH

Đề xuất sách CKUT/chương sách NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay thế cho việc UV không đủ 03 CTKH là tác giả chính theo quy định:

Chú ý: Đối với các chuyên ngành bí mật nhà nước thuộc ngành KH An ninh và KH Quân sự, các tiêu chuẩn không đủ về hướng dẫn, đề tài khoa học và công trình khoa học sẽ được bù bằng điểm từ các bài báo khoa học theo quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg.

d) Biên soạn sách phục vụ đào tạo (đối với ứng viên GS)

- Không đủ điểm biên soạn sách phục vụ đào tạo:

- Không đủ điểm biên soạn giáo trình và sách chuyên khảo:

C. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH:

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2022

Người đăng ký
(Ký và ghi rõ họ tên)